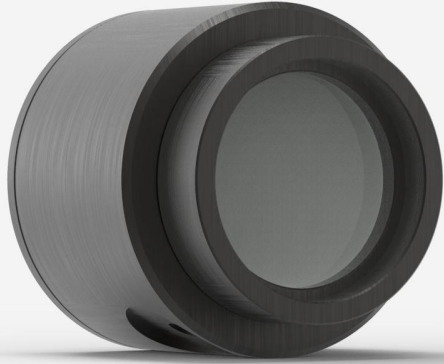


## PH100-SiUV-OD1-DO

최대 38 mW의 레이저 파워 계측용 광전다이오드 검출기.



### 제품군 주요 특징

#### LARGE APERTURES

10 mm Ø for the silicon sensors

#### 3 VERSIONS

- Silicon 350 - 1080 nm, up to 750 mW
- Silicon-UV 210 - 1080 nm, up to 38 mW
- Germanium 800 - 1650 nm, up to 500 mW

#### CHOICE OF ATTENUATORS

- OD0.3: 50% transmission (for PH100-Si<sup>UV</sup> only)
- OD1: 10% transmission
- OD2: 1% transmission

#### HIGH ACCURACY

The new PH100-SI-HA presents the lowest calibration uncertainty to date.

#### PRECISE CALIBRATION

Wavelength selection in 1 nm steps

#### SMART INTERFACE

Containing all the calibration data

호환 스탠드

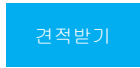
[STAND-D-233](#)

## 사양

계측 성능	
최대 평균 파워 <sup>1</sup>	38 mW
등가노이즈파워 (NEP) <sup>2</sup>	200 pW
스펙트럼 범위	400 - 1080 nm
일반 상승 시간	0.2 s
파워 교정 불확정성 <sup>3</sup>	±5.0 % (400 - 1009 nm) ±7.5 % (1010 - 1080 nm)
첨두 강도	850 nm
최소 반복률 <sup>4</sup>	155 kHz
1. 532nm의 감쇠기. 다른 파장에서의 최대 출력 곡선을 참조하십시오. 2. 850nm. 액면 값. 실제 값은 환경의 전자파 간섭 및 파장에 따라 달라집니다. 3. 감쇠기. 비감쇠기 교정에 대하여 불확실할 경우 사용자 설명서를 참조하십시오. 4. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하세요.	
손상 한계	
최대 평균 파워 밀도	100 W/cm <sup>2</sup>
물리적 특성	
구경 지름	10 mm
업소버	SiUV
치수	38.10 x 36D mm
중량	0.14 kg
센서면까지의 거리	13.7 mm
주문 정보	
PH100-SiUV-OD1-DO	200881

Specifications are subject to change without notice. Refer to the user manual for complete specifications.

## 이 제품에 관심이 있으십니까?



[gentec-eo.com/ko/contact-us](http://gentec-eo.com/ko/contact-us)에서 현지 영업 담당자를 찾으십시오.